

FOTOREZYSTORY

**RPP111, RPP121, RPP130, * (RPP230),
RPP131, RPP140, RPP150, * (RPYP35)**

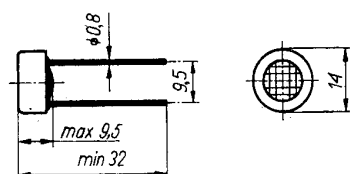
SWW 1156-619

Fotorezystory są detektorami promieniowania widzialnego. Są one przeznaczone do pracy w układach sygnalizacyjnych, kontrolnych, pomiarowych, rejestrujących, sterujących i alarmowych.

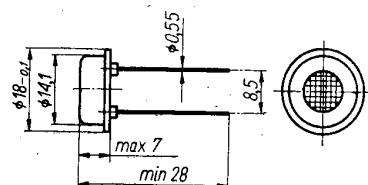
Warstwa światłoczuła jest zbudowana z siarczku kadmu. Dla typów RPP111, RPP121, RPP131, RPP140, RPYP35

elektrody można umieścić w podstawie lampowej typu heptal. W przypadku lutowania końcówek elektrod należy zapewnić odprowadzanie nadmiaru ciepła.

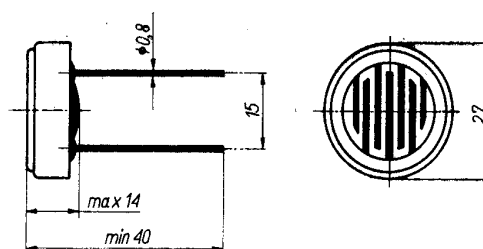
Zasilanie fotorezystorów napięciem stałym lub zmiennym. Przy zasilaniu napięciem zmiennym ($f = 50$ Hz) rezystancja jasna fotorezystora wzrasta o 15% w porównaniu z rezystancją jasną przy zasilaniu napięciem stałym.



Obudowa polistyrenowa fotorezystorów: RPP111, RPP121, RPP130, RPP131, RPP140, RPYP35



Obudowa metalowa fotorezystora RPP230



Obudowa metapleksowa, fotorezystora RPP150

DANE TECHNICZNE

Dopuszczalne wartości parametrów eksploatacyjnych;

$$t_{amb} = 22 \pm 5^\circ\text{C}$$

[illegible]

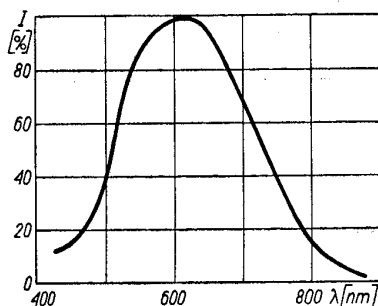
Parametry charakterystyczne: $t_{amb} = 22 \pm 5^\circ\text{C}$

Zakres temperatury

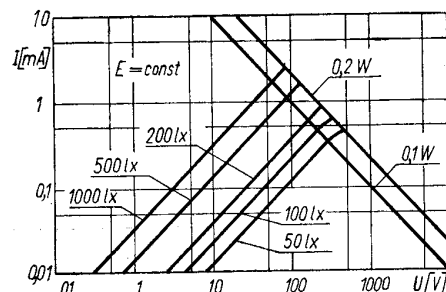
pracy $t_{amb} \quad 248...328 \text{ K } (-25...55^\circ\text{C})$

Maksimum rozkładu widmowego czułości λ_0

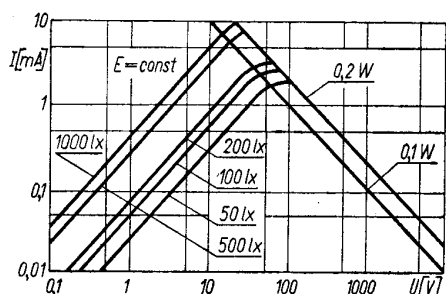
Parametry charakterystyczne	Typ	RPP111	RPP121	RPP130 RPP230	RPP131	RPP140	RPP150	RPYP35	Jed- nostka
Rezystancja jasna($E = 1000 \text{ lx}$) przy $U = 5 \text{ V}$ $U = 10 \text{ V}$ $U = 50 \text{ V}$	R_E	$1 \cdot 10^4 \dots 5 \cdot 10^4$	$1 \cdot 10^3 \dots 1 \cdot 10^4$	$1 \cdot 10^2 \dots 5 \cdot 10^2$	$4 \cdot 10^2 \dots 1,2 \cdot 10^3$	$1 \cdot 10^3 \dots 5 \cdot 10^4$	40....200	25...50	Ω
Rezystancja ciemna przy $U = 50 \text{ V}$ $U = 100 \text{ V}$	R_O	min. $1 \cdot 10^8$	min. $1 \cdot 10^7$	min. $1 \cdot 10^7$	min. $1 \cdot 10^7$	min. $1 \cdot 10^7$	min. $1 \cdot 10^4$	min. $5 \cdot 10^4$	Ω
Prąd jasny ($E = 1000 \text{ lx}$) przy $U_E = 1 \text{ V}$ $U_E = 5 \text{ V}$ $U_E = 10 \text{ V}$	I_E	0,2...1	1...10	10...50	4,15...12,5	2...10	25...125	20...40	mA
Prąd ciemny ($E = 0$) przy $U = 50 \text{ V}$ $U = 100 \text{ V}$	I_C	maks. 1	maks. 10	maks. 5		maks. 10	maks. 100	maks. 1000	μA
Stała czasowa narastania prądu fotoelektrycznego ($E = 200 \text{ lx}$)	τ_{ne}	maks. 0,6					maks. 6	maks. 0,6	s
Stała czasowa zaniku prądu fotoelektrycznego ($E = 200 \text{ lx}$)	τ_{ze}	maks. $5 \cdot 10^{-2}$					maks. $6 \cdot 10^{-2}$	maks. $5 \cdot 10^{-2}$	s
Czułość ($E = 1000 \text{ lx}$)	S	1,1...5,5	28...280	140...700	60...180	57...280	55...270	1430...2860	mA/V·lm
Powierzchnia czynna	A	0,18	0,035	0,14		0,035	0,9	0,14	cm ²



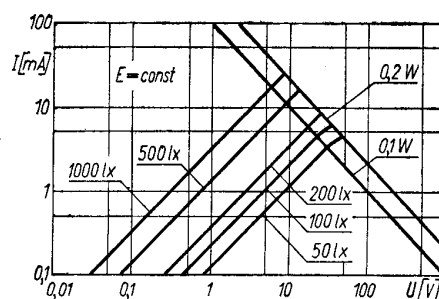
Charakterystyka widmowa (w jednostkach względnych) dla fotorezystorów RPP111, RPP121, RPP130, RPP230, RPP131, RPP140



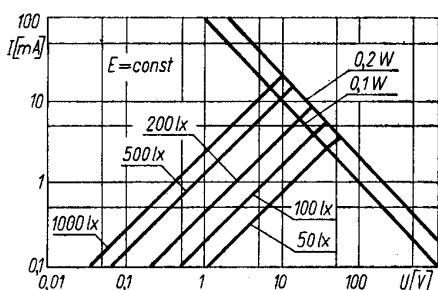
Charakterystyka prądowo-napięciowa fotorezystora RPP111



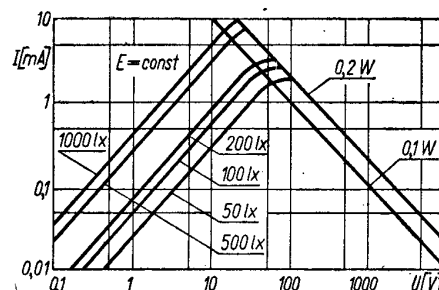
Charakterystyka prądowo-napięciowa fotorezystora RPP121



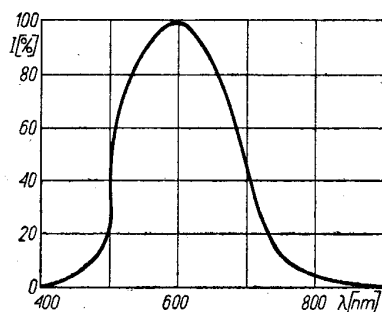
Charakterystyka prądowo-napięciowa fotorezystorów RPP130, RPP230



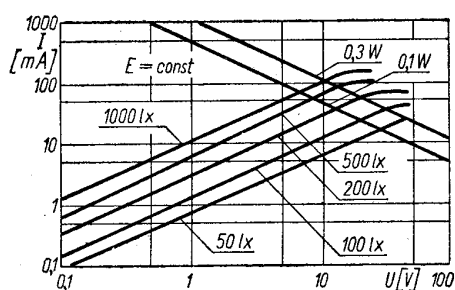
Charakterystyka prądowo-napięciowa fotorezystora RPP131



Charakterystyka prądowo-napięciowa fotorezystora RPP140



Charakterystyka widmowa (w jednostkach względnych) dla fotorezystora RPP150



Charakterystyka prądowo-napięciowa fotorezystora RPP150